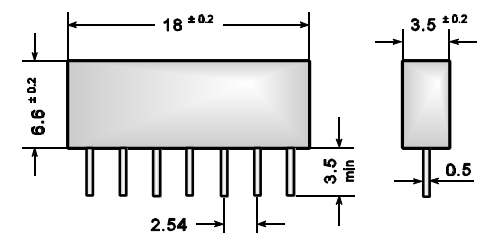


Small Signal Diode Arrays



Dimensions / Maße in mm

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

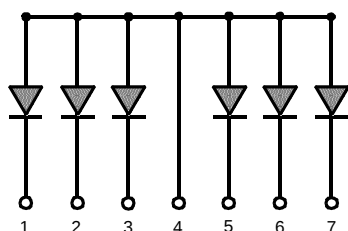
Dioden Sätze mit Allzweckdioden

Nominal power dissipation 200 mW
Nenn-Verlustleistung

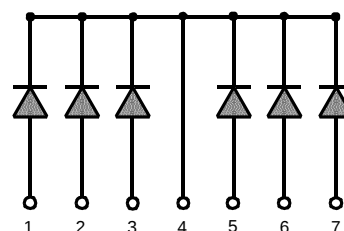
Repetitive peak reverse voltage 80 V
Periodische Spitzensperrspannung

7 Pin-plastic case 18 x 3.5 x 6.6 [mm]
7 Pin-Kunststoffgehäuse

Weight approx. 0,6 g
Gewicht ca.



"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

Maximum ratings

Grenzwerte

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspg.	Stoßspitzensperrspannung
	V_R [V]	V_{RM} [V]
DAN 601	80	80
DAP 601	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, $T_A = 25^\circ\text{C}$
 For one diode operation only $I_{FAV} = 100 \text{ mA}^1)$
 For all diodes together $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^1)$

Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last, $T_U = 25^\circ\text{C}$
 Für eine einzelne Diode $I_{FAV} = 100 \text{ mA}^1)$
 Für alle Dioden zusammen $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^1)$

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, $T_A = 25^\circ\text{C}$ $I_{FSM} = 500 \text{ mA}$
 superimposed on rated load, one diode only
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
 überlagert bei Nennlast, für eine Diode

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	– 50...+150°C

Characteristics			Kennwerte	
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F	< 1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden